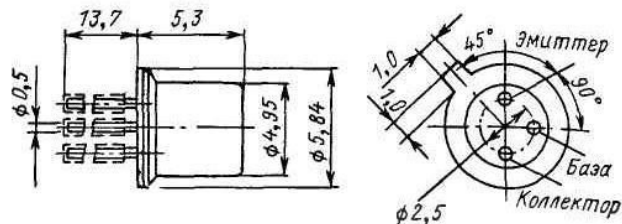


# КТ349А, КТ349Б, КТ349В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* СВЧ универсальные маломощные  
 Предназначены для переключения и усиления сигналов высокой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,5 г.



## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм . . . . .	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	4 В
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 1$ мс . . . . .	40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 303$ К . . . . .	200 мВт
при $T = 358$ . . . . .	108 мВт
Общее тепловое сопротивление . . . . .	600 К/Вт
Температура перехода . . . . .	423 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358 К

## Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА не менее	300 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 10$ мА.	
КТ349А . . . . .	20 - 80
КТ349Б . . . . .	40 - 160
КТ349В . . . . .	120 - 130
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более . . . . .	0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более . . . . .	1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не более	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15$ В, $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм не более . . . . .	1,5 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более . . . . .	6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ не более	8 пФ